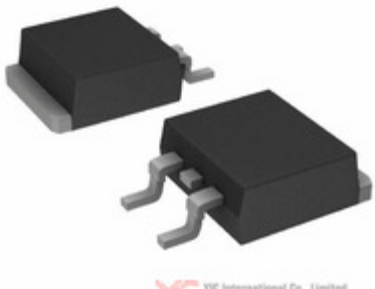
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB60R280P7ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET TO263-3</p>
	<p>Datenblätter: 1.IPB60R280P7ATMA1.pdf 2.IPB60R280P7ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R280P7ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 190µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 3.8A, 10V
Verlustleistung (max)	53W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB60R280P7ATMA1-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	761pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 12A (Tc) 53W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

IPB60R280P7ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB60R280P7ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB60R280P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB60R280P7ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB60R299CPAATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R250CPATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 12A TO263-3</p>	 <p>IPB60R250CP INFINEON IPB60R250CP INFINEON</p>	 <p>IPB60R299CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 11A TO-263</p>
 <p>IPB60R280C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 13.8A TO263</p>	 <p>IPB60R299CPA VB IPB60R299CPA VB</p>	 <p>IPB60R330P6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R280C6 Infineon Technologies IPB60R280C6 Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB60R280P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB60R280P7ATMA1 Datenblatt	IPB60R280P7ATMA1-Datenblätter	IPB60R280P7ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R280P7ATMA1
IPB60R280P7ATMA1 Electronic	IPB60R280P7ATMA1-Komponenten	IPB60R280P7ATMA1-Verteiler	IPB60R280P7ATMA1-Bild	IPB60R280P7ATMA1-Teil
IPB60R280P7ATMA1 Preis	IPB60R280P7ATMA1 Hersteller	IPB60R280P7ATMA1 Bild	IPB60R280P7ATMA1 Aktie	IPB60R280P7ATMA1 Inventar
IPB60R280P7ATMA1 Neu	IPB60R280P7ATMA1 Original	IPB60R280P7ATMA1 garantiert	IPB60R280P7ATMA1 RFQ	IPB60R280P7ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited